

CXYP 44

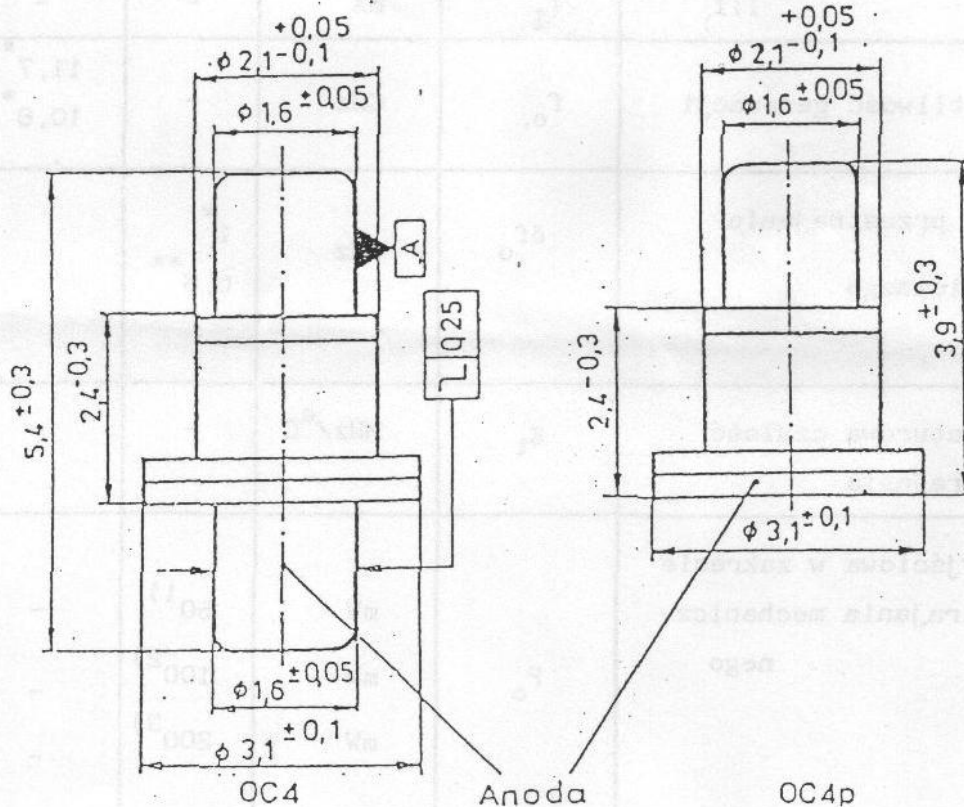
Dioda Gunna

Informacja: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka

tel. (0-22) 47 21 61

fax (0-22) 47 06 31

Diody CXYP 44 są arsenkowo-galowymi diodami Gunna średniej mocy w obudowie ceramiczno-metalowej. Wytwarzane są w dwóch wersjach: CXYP 44A i CXYP 44B o trzech poziomach mocy mikrofalowej w paśmie X.



PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napięcie pracy

V_o

9*
10**

V
V

Prąd pracy

I_o

550*
650**

mA
mA

KARTA KATALOGOWA

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość		
			min.	typ.	max.
Napięcie wejściowe	U_I	V	8	-	12
Prąd wejściowy					
I	I_I	mA	-	-	500 ¹⁾
II	I_I	mA	-	-	700 ²⁾
III	I_I	mA	-	-	1000 ³⁾
Częstotliwość generacji	f_o	GHz	-	11,7 [*] 10,6 ^{**}	-
Zakres przestrajaniamechanicznego	δf_o	GHz	1 [*] 0,5 ^{**}		-
Temperaturowa czułość przestrajaniamechanicznego	g_t	MHz/°C	-	-	1,5
Moc wyjściowa w zakresie przestrajaniamechanicznego	P_o	mW	50 ¹⁾ 100 ²⁾ 200 ³⁾	- - -	- - -

Oznaczenia: 1) - dla mocy 50 mW

2) - dla mocy 100 mW

3) - dla mocy 200 mW

* - dla podtypu A;

** - dla podtypu B;

Przykładowe oznaczenie diody: CXYP 44B2 - dla diody o mocy 100 mW, generującej na częstotliwości 10,6 GHz.



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al.Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel. (0-22) 47 21 61, 43 49 83 • Fax (0-22) 47 06 31